This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. Juli 2001 (19.07.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/52373 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/04317

H01S 5/343

(22) Internationales Anmeldedatum:

4. Dezember 2000 (04,12,2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 01 122.5

13. Januar 2000 (13.01.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von USJ: INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; SL-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): RIECHERT, Henning [DE/DE]: Drosselstrasse 34 C, 85521 Ottobrunn (DE). EGOROV, Anton Yurevitch [RU/RU]; Baskov 19, App. 17, St.Petersburg, 191014 (RU),

- (74) Anwalt: VIERING, JENTSCHURA & PARTNER: Postfach 22 14 43, 80504 München (DE),
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP. KR, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT. BE. CH. CY. DE. DK. ES. FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC. NL. PT. SE. TR).

Veröffentlicht:

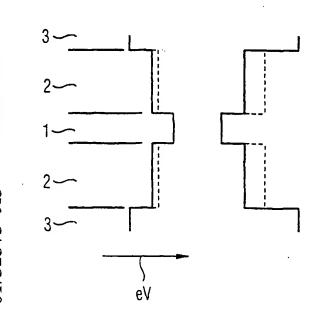
mit internationalem Recherchenhericht

Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 14. März 2002

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SEMICONDUCTOR LASER STRUCTURE

(54) Bezeichnung: HALBLEITERLASERSTRUKTUR



(57) Abstract: The active layer (1) and the barrier layers (2) contain a group III component, a group V component and nitrogen, whereby the active layer is a quaternary material and the barrier layers are ternary materials, or, in order to match the lattice properties of the active layer to the barrier layers, the nitrogen content in the barrier layers is higher. The active layer is preferably InGaAsN, the barrier layers are InGaAsN with higher nitrogen content or GaAsN. Superlattices may exist in the barrier layers, for example, series of thin layers of In, Ga_{1-x} As_y N_{1-y} with varying factors x and y. where, in particular, x = 0 and y = 1.

(57) Zusammenfassung: In der aktiven Schicht (1) und in den Barriereschichten (2) sind eine III-Komponente, eine V-Komponente und N enthalten, wohei die aktive Schicht quaternäres Material und die Barriereschichten ternäres Material sind oder zur Gitteranpassung der aktiven Schicht an die Barriereschichten der Stickstoffanteil in den Barriereschichten höher ist. Die aktive Schicht ist vorzugsweise InGaAsN, die Barriereschichten sind InGaAsN mit höherem Stickstoffanteil oder

GaAsN. In den Barriereschichten können Übergitter (superlattices) vorhanden sein. z.B. Folgen dünner Schichten aus In, Ga_{1-x} As, $N_{1,y}$ mit unterschiedlichen Anteilen x und y, wobei insbesondere x=0 und y=1 sein kann.

International application No. PCT/DE 00/04317

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7: H01S 5/343

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7: H01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ, INSPEC. COMPENDEX. WPI Data

C. DOCUMENTS	CONSIDERED	TO BE	RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	EP 0 621 646 A (SHARP KK) 26 October 1994 (26.10.94) Page 5, line 32-37; Figure 1 Page 3, line 54 Page 7, line 12-16	1,4
A	EP 0 896 406 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 February 1999 (10.02.99) Cited in the application Column 19, line 6-40 Column 21, line 21-28	1, 2, 4
	• .	

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
17 July 2001 (17.07.01)	19 September 2001 (19.09.01)
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office	

Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

International application No. PCT/DE 00/04317

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Change of accument, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Refevant to Claim No.
A	MIYAMATO T ET AL: "A NOVEL GALNNAS-GAAS QUANTUM-WELL STRUCTURE FOR LONG-WAVELENGTH SEMICONDUCTOR LASERS" IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, US, IEEE INC. NEW YORK. Vol. 9, nr. 11, 01 November 1997 (01.11.97), pages 1448-1450, XP000722969 ISSN: 1041-1135 Cited in the application Page 1449, left-hand column, last paragraph; Figure 2	1, 4
A	US 5 825 796 A (JEWELL JACK L ET AL) 20 October 1998 (20.10.98) Cited in the application Column 5 Column 18 Column 26-27	1, 4
A	US 5 689 123 A (WELCH DAVID F ET AL) 18 November 1997 (18.11.97) The whole document	1, 4

International application No. PCT/DE00/04317

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Into	ernational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
	See additional sheet
 -	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
, X	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1-6
Remar	k on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No

PCT/DE00/04317

The international search authority has established that this international application contains multiple inventions, as follows:

1. Claims: 1-6

semiconductor laser structure, whereby the active layer and the barrier layers are each a semiconductor material which comprises a III component, a V component and nitrogen

1.1. Claims: 1-3

barrier layers comprising a larger proportion of nitrogen as active layer

1.2. Claims: 4-6

active layer quaternary material and barrier layer tertiary material

2. Claims: 7-11

semiconductor laser structure, whereby the active layer and barrier layers each comprise a semiconductor material and the barrier layers form a superlattice.

Please note that for all inventions cited under point 1 a full search was carried out without the expense of an additional search fee, although all the above inventions are not absolutely linked by a common inventive concept.

Information on patent family members

International Application No

PCI/DE 00/04317

Patent document cited in search report		Publication date	Patent familiy member(s)	Publication date
EP 0621646	А	26-10-1994	GB 2277405 DE 69419451 DE 69419451 JP 7007223 US 5583351	D 19-08-1999 T 09-12-1999 A 10-01-1995
EP 0896406	A	10-02-1999	JP 11288886 JP 11112096 US 6256331	A 23-04-1999
US 5825796	A	20-10-1998	AU 4588597 WO 9813879 US 5960018	A 02-04-1998
US 5689123	Α	18-11-1997	US 6130147 US 6100546	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter Conales Aktenzeichen PC+/DE 00/04317

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H01S5/343 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01S Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstott gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, WPI Data C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie* Betr. Ansoruch Nr. Χ EP 0 621 646 A (SHARP KK) 1.4 26. Oktober 1994 (1994-10-26) Seite 5, Zeile 32-37; Abbildung 1 Seite 3, Zeile 54 Seite 7, Zeile 12-16 EP 0 896 406 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO Α 1,2,4 LTD) 10. Februar 1999 (1999-02-10) in der Anmeldung erwähnt Spalte 19, Zeile 6-40 Spalte 21, Zeile 21-28 -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *E* ålteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung ür einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) ausgeunn; Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anme/dedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 1 9, 09, 01 17. Juli 2001 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. CLAESSEN, L Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inters anales Aktenzeichen
PC1/DE 00/04317

1,4
1,4
1,4

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 00/04317

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich
2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgetaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
siehe Zusatzblatt
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgeforden.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt: 1-6
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-6

halbleiterlaserstruktur bei der die aktive schicht und barriereschichten jeweils ein halbleitermaterial sind das eie III-komponente, eine V-komponente und Stickstoff enthält

1.1. Ansprüche: 1-3 barriereschichten ethälten einen höheren Anteil Stickstoff als aktiven Schicht

1.2. Ansprüche: 4-6
aktive Schicht quaternäres material und
Barriereschichten ternäres material

2. Ansprüche: 7-11

halbleiterlaserstruktur bei der die aktive schicht und barriereschichten jeweils ein halbleitermaterial sind das eine Barriereschichten bilden ein Übergitter.

Bitte zu beachten daß für alle unter Punkt 1 aufgeführten Erfindungen, obwohl diese nicht unbedingt durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden sind, ohne Mehraufwand der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, eine vollständige Recherche durchgeführt werden konnte.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichu die zur selben Patentfamilie gehoren

Interi nales Aktenzeichen PCI/DE 00/04317

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokur	-	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie				Datum der Veröffentlichung
EP 0621646	Α	26-10-1994	GB DE DE JP US	2277405 A 69419451 D 69419451 T 7007223 A 5583351 A	26-10-1994 19-08-1999 09-12-1999 10-01-1995 10-12-1996		
EP 0896406	A	10-02-1999	JP JP US	11288886 A 11112096 A 6256331 B	19-10-1999 23-04-1999 03-07-2001		
US 5825796	A	20-10-1998	AU WO US	4588597 A 9813879 A 5960018 A	17-04-1998 02-04-1998 28-09-1999		
US 5689123	Α	18-11-1997	US US	6130147 A 6100546 A	10-10-2000 08-08-2000		